# Sn ペロブスカイト薄膜の GHz 誘電率の光制御

## Control of GHz Permittivity of Sn-Based Perovskite Films via Photo-Excitation

阪大院工<sup>1</sup>, 首都大院理<sup>2</sup>, 九工大生命<sup>3</sup>, JST さきがけ<sup>4</sup> <sup>0</sup>山田 研人<sup>1</sup>, 西久保 綾佑<sup>1</sup>, 大賀 光<sup>1</sup>,

## 今村 穰2, 尾込 裕平3, 早瀬 修二3, 佐伯 昭紀 1.4

#### Osaka Univ.<sup>1</sup>, Tokyo Metropol. Univ.<sup>2</sup>, Kyutech.<sup>3</sup>, JST-PRESTO<sup>4</sup> <sup>O</sup>Kento Yamada<sup>1</sup>, Ryosuke

Nishikubo<sup>1</sup>, Hikaru Oga<sup>1</sup>, Yutaka Imamura<sup>2</sup>, Yuhei Ogomi<sup>3</sup>, Shuzi Hayase<sup>3</sup>, Akinori Saeki<sup>1,4</sup>

#### E-mail: saeki@chem.eng.osaka-u.ac.jp

有機半導体中の電荷キャリアはクーロン力を介して結晶格子と相互作用し、ポーラロンを形成する。このキャリアー格子間の相互作用は、エネルギー緩和や移動度の低下を引き起こす一方、太陽電池などの デバイスにおいて電荷を外部電場から遮蔽し、再結合を抑制するという重要な役割を有している。また、 有機無機ペロブスカイト中では、メチルアンモニウムカチオン(MA)の配向による強誘電体効果ないし、ス ピンー格子相互作用によるバンド分裂(Rashba 効果)によって、正負電荷が遮蔽されることで電荷再結合 が抑制されることが計算化学から提案されている。この時、格子の外部電場に対する応答も変わるため、 誘電率も変化すると考えられる。

この仮説のもと、光励起時間分解マイクロ波伝導度法(TRMC)法を用いてキャリア—格子相互作用に よる誘電率変化の評価を試みた。通常の有機・無機半導体のTRMC 測定では、光照射で生成した電荷 キャリアがマイクロ波吸収信号を誘起し、再結合や緩和過程によって信号の減衰が観測される。通常、周 波数変調(Frequency-Modulated: FM-)TRMC では、電荷キャリアによって正の実部伝導度信号( $\Delta \sigma$ '>0) =正の虚部誘電率信号( $\Delta \epsilon$ ">0)と、負の虚部伝導度信号( $\Delta \sigma$ "<0)=正の実部誘電率信号( $\Delta \epsilon$ ">0)が観 測される<sup>1</sup>。しかし、電荷キャリアが格子との相互作用により束縛(自己束縛)された場合、電荷キャリアによ る通常の信号( $\Delta \epsilon$ '>0,  $\Delta \epsilon$ ">0)に加えて、格子の誘電率の減少によって、通常の信号とは逆の符号をもつ 異常信号( $\Delta \epsilon$ '<0,  $\Delta \epsilon$ "<0)が現れると考えた。そこで、代表的な無機誘電体ペロブスカイト材料: チタン酸 バリウム(BTO)とチタン酸ストロンチウム(STO)を評価したところ、Tiの変位によって引き起こされる電荷キ ャリアの自己束縛に起因する信号が得られた。しかし、BTOとSTOの誘電率の変化量は小さく、また、強 い励起光強度が必要であった。

そこで、誘電率変化の増加を期待して、鉛(Pb)およびスズ(Sn)系の有機無機ペロブスカイトに着目した。これまでに報告したMAPbI<sub>3</sub>ペロブスカイトのFM-TRMCでは、通常の電荷キャリアによる信号( $\Delta\sigma$ '>0,  $\Delta\sigma$ ''<0)のみが観測されている<sup>2</sup>。しかし、Sn ペロブスカイトでは、BTO,STOよりも弱い励起光で巨大な異

常信号(Δσ'<0, Δσ">0)が観測された<sup>3</sup>。有機カチオンを Cs カチオンに換えて測定を行ったところ、異常信号は観 測されなかった。この結果から、有機カチオン双極子の回 転が自己束縛をもたらすと推測される。当日は Pb/Sn の比 率や I/Br の比率を変えた評価結果と共に機構について議 論する。

[1] A. Saeki, Y. Yasutani, H. Oga, S. Seki, J. Phys. Chem. C 2014, 118, 22561.

- [2] H. Oga, A. Saeki, Y. Ogomi, S. Hayase, S. Seki, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 13818.
- [3] K. Yamada, A. Saeki et al., Manuscript in preparation.



**Figure 1.** Schematic illustration of self-trapping of carriers.